

应用于反激转换器的同步整流器

特点

- 内置 17mΩ 40V Trench MOSFET
- 支持 DCM 和 QR 工作模式
- 精确的同步功率管 VDS 电压检测
- 驱动能力 SINK 与 SOURCE 分别大 1.4A/0.6A
- 具有低至 20nS 的功率管快速关断能力
- VDD欠压保护
- SOP8封装

概述

WS2212C是一个应用于开关电源系统的,高性能的同步整流芯片。

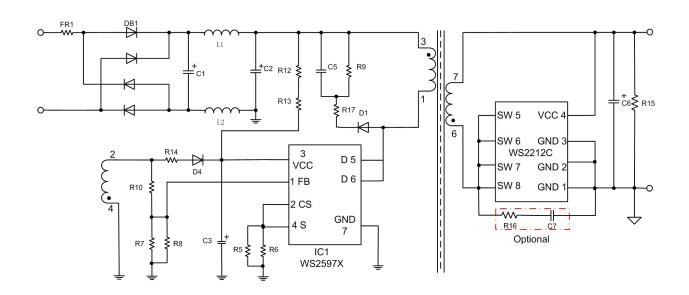
WS2212C集成高性能的同步整流控制器和低导通阻抗的功率管,来取代传统反激转换器系统中的肖特基二极管,可以减少热损耗,增大输出电流能力并提高了效率。

WS2212C提供齐全的保护功能,提高系统的可靠性。 WS2212C提供SOP8的封装形式。

应用领域

- AC/DC 5V/适配器
- 手机充电器
- 低压大电流整流电路

典型应用图

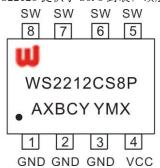


WINSEMI MICROELECTRONICS WINSEMI WINSEMI



引脚定义与器件标识

WS2212C 提供了 SOP8 封装, 顶层如下图所示:



WS2212CS8P: Product Code

A: 产品编码 X: 内部代码

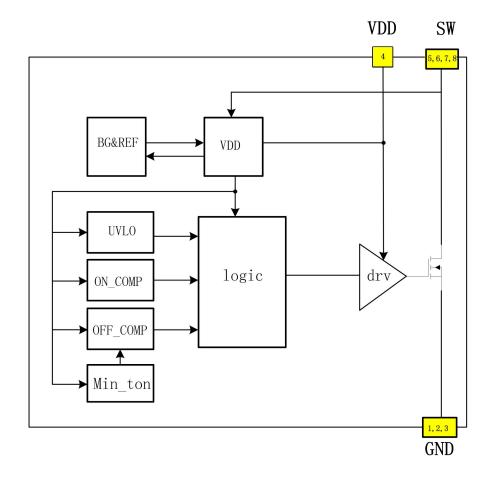
BCY: 内部品质管控代码

YMX: D/C

引脚功能说明

| 引脚名 | 引脚号 | 引脚类型 | 功能说明 |
|-----|------------|------|----------|
| GND | 1, 2, 3 | 地 | 地 |
| VDD | 4 | 输入 | 芯片电源 |
| SW | 5, 6, 7, 8 | 输入 | 内置功率管的漏端 |

电路内部结构框图



订购信息

| 封装形式 | 芯片表面标识 | 采购器件名称 |
|------|------------|---------|
| SOP8 | WS2212CS8P | WS2212C |

WINSEMI MICROELECTRONICS WINSEMI WIN



3/6

推荐工作范围

| 符号(symbol) | 参数 (parameter) | 值 (value) | 单位 (unit) |
|------------|----------------|---------------------|------------|
| TA | 操作温度 | -40 [~] 85 | $^{\circ}$ |

极限参数

| 参数 | 极限值 | 单位 |
|--------------|----------------------|------------------------|
| VDD | -0.3 [~] 8 | V |
| SW | -1 [~] 40 | V |
| 结温范围 | -40 [~] 150 | $^{\circ}$ |
| 焊锡温度(焊锡,10秒) | 260 | $^{\circ}$ |
| 存储温度 | -55 [~] 150 | $^{\circ}\!\mathbb{C}$ |

注意:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久损坏。不推荐将该器件工作在以上极限条件,工作在极限条件以上,可能会影响器件的可靠性。

电气特性参数

条件: VDD=5V, T=25℃. (除非特别注明)

| 符号 | 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|-----------|--------------------|--------------------------------|-------|------|------|----|
| | | 电源部分 | • | • | | |
| 静态工作电流 | IQ | VDD=5V | | 130 | 190 | uA |
| 启动电压 | VDD_ON | | | 4 | | V |
| 欠压锁定电压 | VDD_UVLO | | 2.8 | 3 | 3. 1 | V |
| VDD 工作电压 | VDD | | 4. 55 | 5. 4 | 8. 0 | V |
| | | 同步侦测部分 | | | | |
| 同步管开启电压 | VON_SR | | | -0.5 | | V |
| 同步管关断电压 | VOFF_SR | | | -3 | | mV |
| 同步管开启延时 | Tdon | | | 100 | | nS |
| 同步管关断延时 | Tdoff | | | 6 | | nS |
| 同步管最小开启时间 | Ton_min | | | 1 | | uS |
| | | 功率管驱动部分 | | | | |
| 驱动上拉电流能力 | Isource | | | 0.6 | | A |
| 驱动下拉电流能力 | Isink | | | 1.5 | | A |
| 功率管开启上升时间 | Trise | | | 50 | | nS |
| 功率管关断下降时间 | Tfall | | | 20 | | nS |
| | | 功率管 | | • | | |
| 功率管导通阻抗 | R _{DS_ON} | V_{GS} =4. 5V/ I_{DS} =20A | | 17 | 27 | mΩ |
| 内置功率管耐压 | BV _{DSS} | V_{GS} =0V/ I_D =250uA | 40 | 45 | | V |

winsemi microelectronics winsemi microelectron



功能描述

WS2212C 是,一个应用于开关电源系统的高性能同步整流 芯片,此芯片用来取代反激变换器中的肖特基二极管,可以提 高效率,降低温度损耗。WS2212C 可支持 DCM 和 QR 工作模式满 足 5V 充电器、适配器系统。其供电方式是通过系统输出直接 供电。

VDD 欠压锁定(UVLO)

WS2212C 在芯片上电过程中应用了 UVLO 功能,当 VDD 引脚的电压上升到 VDD 的启动电压时, 芯片从 LATCH 模式中恢复过来进入正常工作模式,此时功率管可以被正常开启;当 VDD 电压下降到 VDD 欠压锁定电压时,芯片再次进入欠压锁定模式,功率管处于关断状态。

最小开启时间

WS2212C 控制电路可以控制同步管具有最小导通功能。在 功率管开启时,次边寄生元件会产生高频噪声,而这些高频噪 声可能会引起功率管被误关断,而此最小导通时间可以有效屏 蔽误关断信号,保证功率管可以维持 1.5uS 的开启时间。

同步整流管开启

WS2212C 通过检测功率管的 VDS 电压来控制其的开启。当反激转换器原边关断,次边开始消磁时,次边电流首先通过功率管的体二极管开始续流并产生一个 vbe 压降,这样功率管的漏极电压将下降到-0.7V 左右。如图 1 所示,WS2212C 如果首先检测到功率管的漏端是大于 0.7V,然后又检测到其电压下降到-0.7V,则会在 100nS 左右的延时之后,开启功率管。

同步整流管关断

当同步管开启之后,随着次边续流电流的逐渐减小,同步管的漏端电压会逐渐上升。如图 1 所示,WS2212C 检测到次边电流小于其内部设置的关断电流后,会迅速关断功率管,其关

断延时小于 10nS。

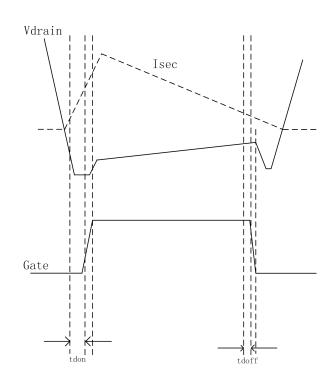


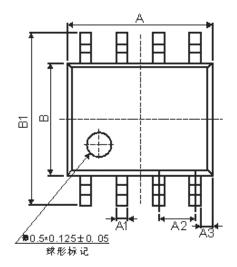
图 1 SR 管开启及关断时序

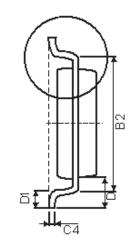
4/6

WINSEMI MICROELECTRONICS WINSEMI MICROELECTRONICS WINSEMI MICROELECTRONICS WINSEMI MICROELECTRONICS WINSEMI MICROELECTRONICS

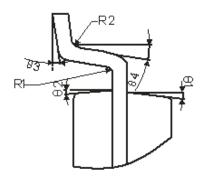


SOP8 封装外观图









| | Winsemi | | | | |
|--------|---------------------------|--------|----------------------|--------|--|
| 0 1 1 | Dimensions in Millimeters | | Dimensions in Inches | | |
| Symbol | Min | Max | Min | Max | |
| A | 4.70 | 5. 10 | 0. 185 | 0. 201 | |
| В | 3.70 | 4. 10 | 0. 146 | 0. 161 | |
| С | 1.30 | 1. 50 | 0. 051 | 0. 059 | |
| A1 | 0.35 | 0. 48 | 0.014 | 0. 019 | |
| A2 | 1. 27TYP | | 0. 05TYP | | |
| A3 | 0. 345TYP | | 0. 014TYP | | |
| B1 | 5. 80 | 6. 20 | 0. 228 | 0. 244 | |
| B2 | 5. 00TYP | | 0. 197TYP | | |
| C1 | 0. 55 | 0.70 | 0. 022 | 0.028 | |
| C2 | 0. 55 | 0.70 | 0. 022 | 0.028 | |
| C3 | 0.05 | 0. 225 | 0.002 | 0.009 | |
| C4 | 0. 203TYP | | 0.008TYP | | |
| D | 1.05TYP | | 0. 041TYP | | |
| D1 | 0.40 | 0.80 | 0.016 | 0.031 | |

WINSEMI MICROELECTRONICS WINSEMI WINSEMI WINSEMI MICROELECTRONICS WINSEMI WINSEMI



注意事项

- 1. 购买时请认清公司商标,如有疑问请与公司本部联系。
- 2. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值,否则会影响整机的可靠性。
- 3. 本说明书如有版本变更不另外告知。

联系方式

深圳市稳先微电子有限公司

公司地址:深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1002

邮编: 518040

总机: +86-755-8250 6288 传真: +86-755-8250 6299

网址: www.winsemi.com

WINSEMI MICROELECTRONICS WINSEMI WIN